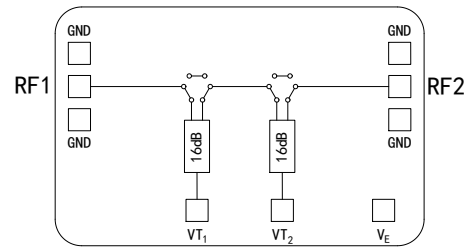


### 特点:

- 频率范围: 0.01~6GHz
- 插入损耗: 1dB
- 衰减步进: 16dB
- 衰减位数: 2 位
- 单电源工作: -5V@4mA
- 芯片尺寸: 0.9mm×0.9mm×0.1mm

### 功能框图:



### 产品简介:

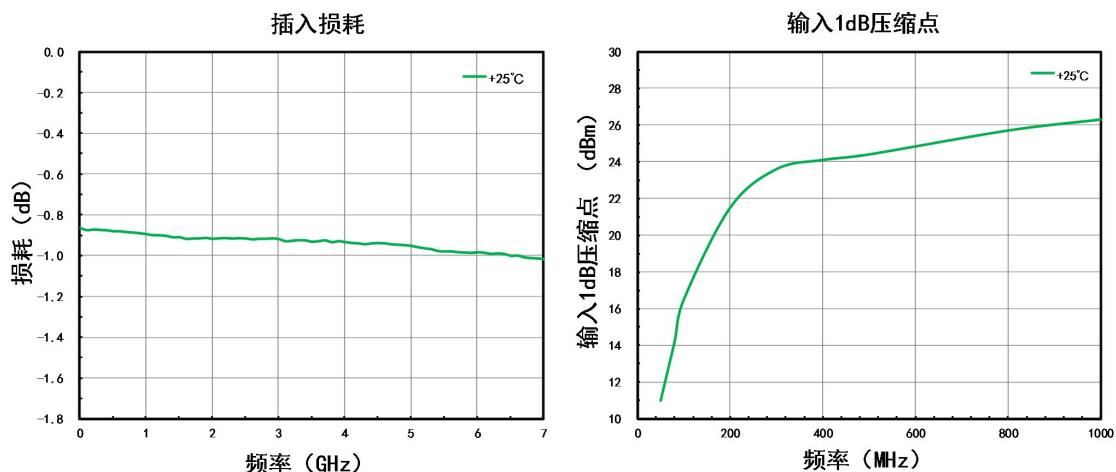
YDC4308 是一款采用 GaAs 工艺设计制造的 2 位数控衰减器芯片，其基本衰减态为 16dB、16dB，总衰减量为 32dB。该芯片采用了片上金属化通孔工艺保证良好接地。芯片背面进行了金属化处理，适用于导电胶粘接或共晶烧结工艺。

### 性能参数: (50Ω系统, TA=+25°C, VE=-5V, IE=4mA)

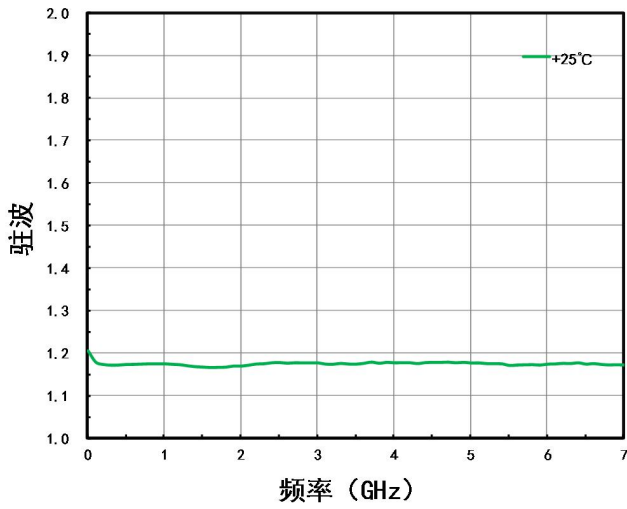
参数名称	符号	测试条件	参数值			单位	备注	
			MIN	TYP	MAX			
频率范围	f	VE=-5V f=0.01~6GHz 控制电平: 0/+5V VE=-5V	0.01		6	GHz		
插入损耗	IL			1		dB		
端口驻波比	VSWR			1.2:1				
衰减步进	LSB			16		dB	额定值	
衰减范围	A			16~32		dB		
衰减精度	ΔA			-1.8~-0.5		dB		
衰减附加相移	Δφ			0		+18	°	
输入 1dB 压缩点	IP-1dB				+24		dBm	0 态
控制电平	VT <sub>H</sub>			+4		+5.5	V	
	VT <sub>L</sub>			0		+0.5	V	
开关时间	t			10.8		ns	参考态→全衰减态时间	
				15.2		ns	全衰减态→参考态时间	
电源电压	VE		-4.75	-5	-5.25	V	功能正常	
电源电流	IE			4		mA		

\*: 芯片均经过在片 100% 直流与 RF 测试。

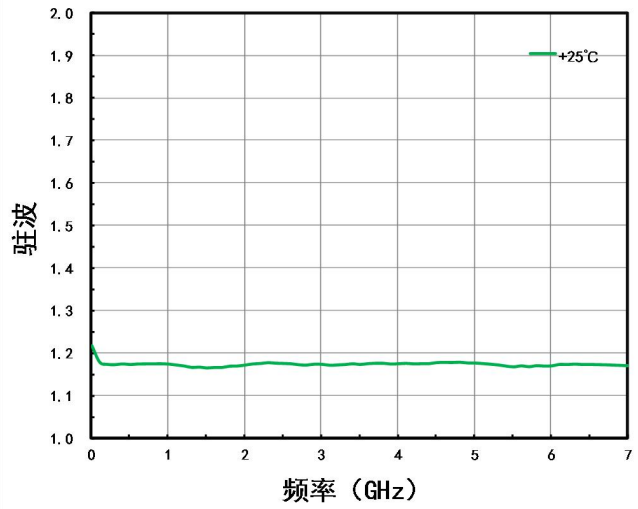
### 典型测试曲线: (50Ω系统, TA=+25°C, VE=-5V, IE=4mA)



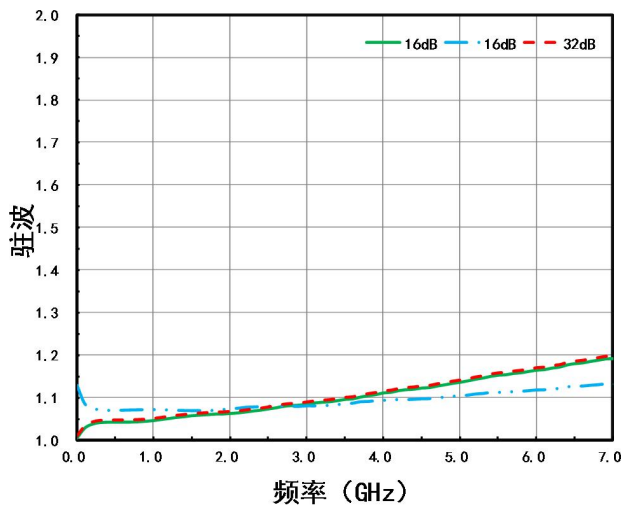
输入驻波 (0态)



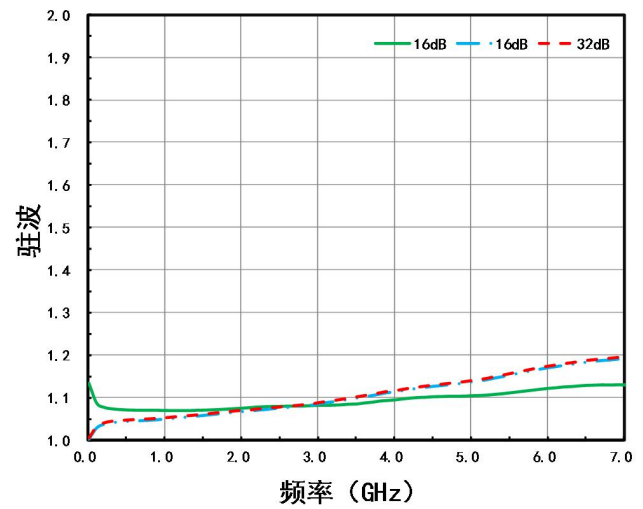
输出驻波 (0态)



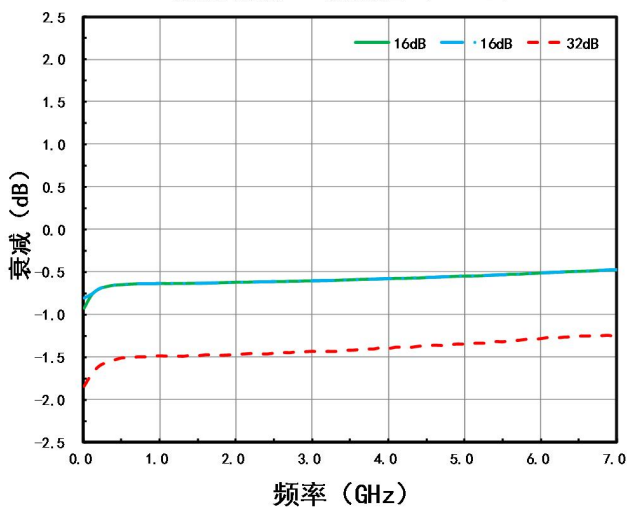
输入驻波VS. 衰减位 (+25°C)



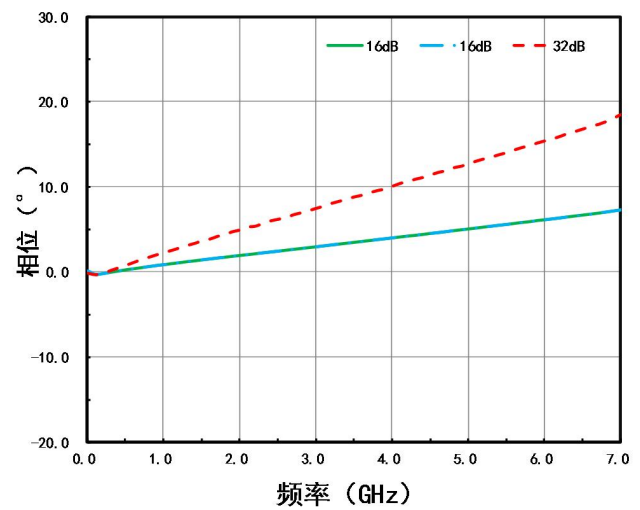
输出驻波VS. 衰减位 (+25°C)



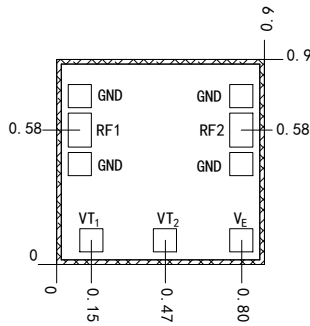
衰减精度VS. 衰减位 (+25°C)



衰减附加相移VS. 衰减位 (+25°C)



### 外形尺寸图:



注: 1.单位: mm;

2.芯片背面镀金, 背面接地;

3.外形尺寸公差:  $\pm 0.05\text{mm}$ 。

4.键合压点镀金, 压点尺寸:  $0.1 \times 0.1\text{mm}$ ;

### 真值表: (0: 0V, 1: +5V)

衰减量	控制输入	
	VT <sub>1</sub>	VT <sub>2</sub>
参考态	0	0
16dB	1	0
16dB	0	1
32dB	1	1

### 引脚定义:

符号	描述
RF1	射频端口 1, 无隔直
RF2	射频端口 2, 无隔直
V <sub>E</sub>	电源端, -5V 加电
VT <sub>1</sub>	16dB 衰减控制端, 高电平有效
VT <sub>2</sub>	16dB 衰减控制端, 高电平有效
GND/芯片背面	接地

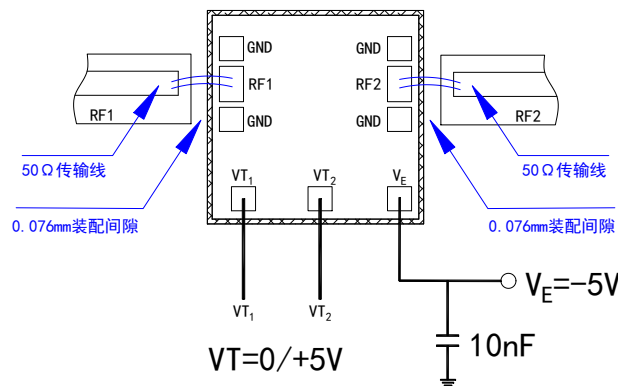
### 极限参数表:

参数名称	极限值
输入射频功率.50Ω	+25dBm
电源电压	-5.5V
控制电压	+5.5V
装配温度	+295°C, 30s
工作温度	-55°C~+125°C
贮存温度	-65°C~+150°C

超过以上任何一项极限参数, 可能造成器件永久损坏。



### 推荐装配图:



注: 射频端口应尽量靠近微带线以缩短键合金丝尺寸, 典型的装配间隙是 0.076~0.152mm, 使用  $\Phi 25\mu\text{m}$  双金丝键合, 建议金丝长度 250~400 $\mu\text{m}$ 。

### 产品使用注意事项:

1. 本芯片产品需要在干燥、氮气环境中存储, 在超净环境装配使用。
2. 裸芯片使用的砷化镓材料较脆, 芯片表面容易受损, 不能用干或湿化学方法清洁芯片表面使用时必须小心。
3. 芯片粘接装配时, 需考虑热膨胀应力对芯片的影响, 芯片建议烧结或粘结在热膨胀系数相近的载体上, 如可伐、钨铜或钼铜垫片上, 避免热膨胀应力匹配不当导致芯片开裂。
4. 芯片底部用导电胶粘接。
5. 芯片射频端口使用 25 $\mu\text{m}$  双金丝键合, 建议金丝长度 0.25~0.40mm (10~16 mils)。
6. 产品对静电敏感, 在存储和使用过程中注意防静电。
7. 具体使用说明详见《裸芯片产品使用说明》。